产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

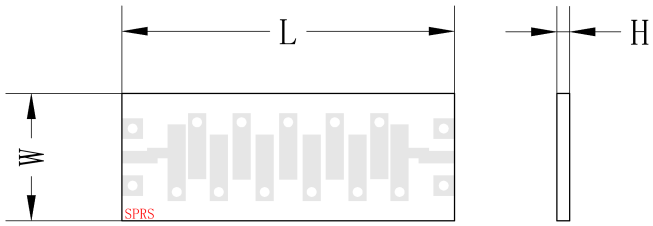
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	11.5	GHz
工作带宽	10.2-12.8	GHz
中心损耗	2.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-8.9GHz	dBc
带外抑制	40@14.3-25.0GHz	dBc

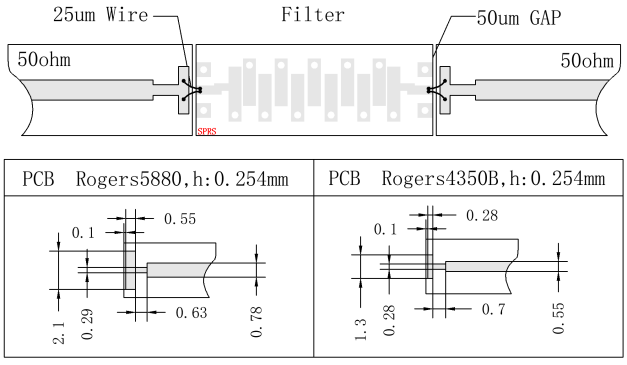
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.5，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



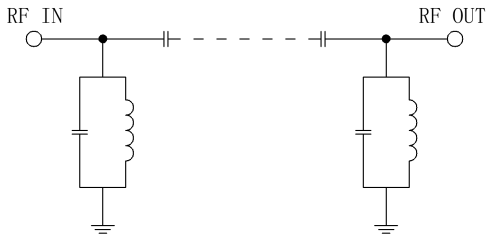
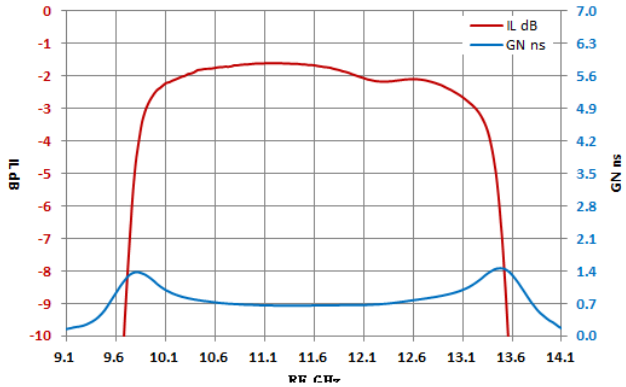
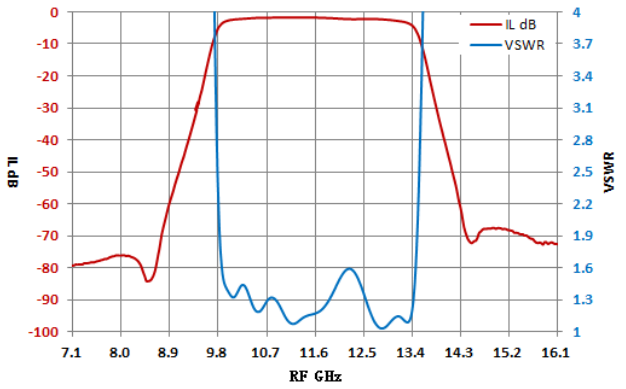
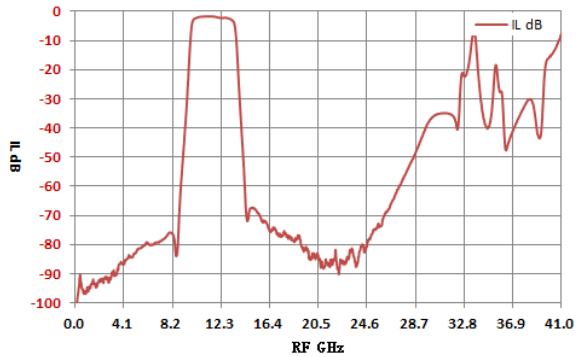
推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线